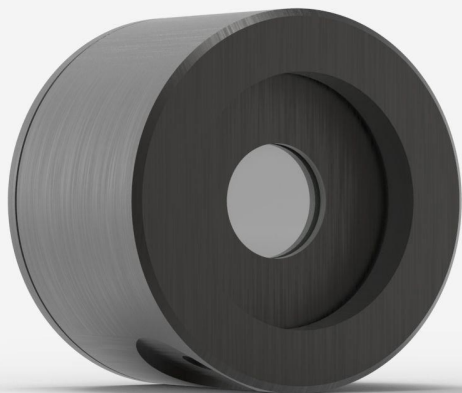


PH100-SiUV-DO

最大4 mWまでのレーザー出力測定用フォトダイオードディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

大型アパーチャ

シリコンセンサーには10 mm ϕ

3つのバージョン

- シリコン350 - 1080 nm、最大750mW
- シリコンUV 210 - 1080 nm、最大38mW
- ゲルマニウム800 - 1650 nm、最大500mW

アッテネーターの選択

高精度

新 PH100-Si-HAは、キャリブレーションの安定性に優れています。

精密較正

1nmステップでの波長の選択

スマートインターフェース

すべての較正データを収容

互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

仕様

| 測定性能 | |
|--|--|
| 最大平均出力 ¹ | 4 mW |
| ノイズ等価出力 ² | 10 pW |
| スペクトル領域 | 210 - 1080 nm |
| 標準上昇時間 | 0.2 s |
| 出力較正不確か率 | ±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±2.5 % (400 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm) |
| ピーク感度 | 0.45 A/W @ 850 nm |
| 最小繰り返し率 ³ | 155 kHz |
| 1. 532 nmで。その他の波長における最大出力については曲線を参照してください。 2. 850 nmで。公称値。実際値は周囲の電磁妨害および波長に応じて異なります。 3. 詳細についてはユーザーマニュアルを参照してください。 | |
| 損傷閾値 | |
| 最大平均出力密度 | 100 W/cm ² |
| 物理的特徴 | |
| 開口直径 | 10 mm |
| 吸収材 | SiUV |
| 寸法 | 38.1 ϕ x 27.4D mm |
| 重量 | 0.13 kg |
| センサ正面までの距離 | 13.7 mm |
| 注文情報 | |
| PH100-SiUV-DO | 200879 |
| PH100-SiUV-IDR-DO | 203231 |
| PH100-SiUV-INT-DO | 202788 |

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください